

## تأثير الاشعاع البصري للمصابيح الرقيقة على خصائص استشعار الغاز الكهربائية لاغشية ثاني اوكسيد القصدير $\text{SnO}_2$

المؤلفون : س.ي.ريميزا، ت.ف.سفينستوفا ، وصفي محمد التميمي ،س.ف.اوسيانيكوف،ك.ن.باغنيوكوف.

في هذا العمل يتم البحث في التأثير البصري لأشعة المصابيح الرقيقة ذات الطيف البنفسجي على درجة المقاومة الكهربائية ومدى القابلية على الاستشعار في اجهزة القياس الاستشعاري لاغشية ثاني اوكسيد القصدير والتركيب المختبرية لاجهزه قياس الغازات . تم تحديد مميزات تغير المقاومة للمادة الاستشعرية عند تشغيل واغلاق الضوء. وقد تم الاستناد على ان الفاعلية البصرية لغشاء ثاني اوكسيد القصدير يساهم بشكل كبير في مضاعفة الاستشعار الغازي لاجهزه والذي ويؤدي الى ظهور الاستشعار الغازي باعلى مستوياته حيث يصل الى الضعفين عن الحد الادنى بالمقارنة مع درجة الحرارة العليا لاجهزه القياس الاستشعرية للغازات بدون تسليط الضوء.

الكلمات الافتتاحية : اجهزة قياس الغازات ، التحسس، المصباح الرقيق، الضوء المحفز.

ان اجهزة قياس استشعار الغاز المعدنية المؤكسدة والتي تعلوها اغشية ثاني اوكسيد القصدير  $\text{SnO}_2$  و اوكسيد الزنك ZNO يستخدم بشكل واسع في مراقبة الغلاف الجوي . ونتيجة التأثير البطيء والغير ملاحظ للغاز على سطح الفولاذ المؤكسد في درجة حرارة الغرفة لاجهزه الاستشعار المعدنية للغازات بحيث تعمل في درجة حرارة تصل الى  $300-400$  بحيث تكون خطرة عند محاولة تحجيمها في اطار ضيق في الهواء والتي يمكن ان تؤدي الى الانفجار . ان واحدة من الاساليب المتبعة لتقليل درجة حرارة عمل اجهزة قياس الاستشعار المكونة من ثاني اوكسيد القصدير هو زيادة اعمليات الامترار على السطح الشبه موصل للاشعة فوق البنفسجية وظهور سمات استشعار الغاز لاوكسيد الكاربون CO وثاني اوكسيد النيتروجين  $\text{NO}_2$  في درجة حرارة الغرفة . بعد الاسلوب النظري لتقنية التأثير المقابل للاشعة فوق البنفسجية على سطح الفولاذ المؤكسد لاشباء الموصلات احد الخيارات للسماح بالتقدير النوعي لخاصية التغير في المقاومة وفي اغشية اجهزة الاستشعار الغازية بغض النظر عن كثافة التيار الضوئي المتدافق ودرجة حرارة الوسط المحيط.

لا بد من الاشارة الى ان مصادر الاشعاع الضوئي المستخدمة في الاعمال البحثية السابقة على شكل مصابيح الزينون الثابتة القوية والمصابيح الزئبقيه والتي لا تتناسب الاستعمال التطبيقي مع اجهزة الاستشعار المحمولة ذات التغذية المستقلة . وفي هذه الحالة فمن المناسب استعمال المصابيح ذات الاضاءة البنفسجية ونطاق الاشعة فوق البنفسجية ذات الموجة الطويلة .

في هذا العمل البحثي يتم التطرق الى نتائج تأثير الاشعاع ذات الموجة القصيرة للمصابيح الرقيقة على درجة المقاومة الكهربائية لطبقات الاجهزه التي يدخل ثاني اوكسيد القصدير  $\text{SnO}_2$  في التركيب المختبرية لاجهزه استشعار الغاز واستشعار انواع اخرى من الغازات .

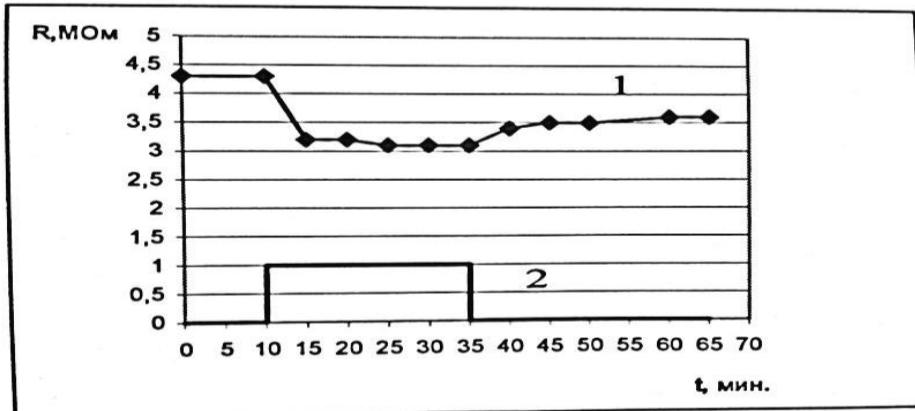
بصيغة اشكال مختبرية استخدمت تراكيب فحص لاستشعار الغازات معدة بتقنية الالكترونيات الدقيقة على اغشية اجهزة القياس المكونة من  $\text{SnO}_2$  . يأخذ البلور حيز  $1 \times 1$  ، و اغشية التوصيل البلاستيكية الكهربائية على الطبقات الموجودة على مسافة  $10 \text{ mkm}$ . ان تسخين على اغشية البلاتين الرقيقة في اجهزة الاستشعار تسمح بمضاعفة درجة الحرارة حتى تصل الى  $450$  درجة -  $500$  درجة لكي يكون الامتراء على السطح الاستشعاري بعد حفظه لفترة طويلة في الهواء . ان بلورات الاجهزه تتضاعد في الاشكال المعدنية الخزفية المتكاملة التركيب لقياس مدى مقاومة اجهزة القياس في امدادات التيار الكهربائي عند تسخين الاجهزه. ولقياس مدى مقاومة اجهزة القياس دقيق انتاجه شركة mastech ويحمل الرقم التسلسلي my46 بحدود اهمية المقاومة المسيطر عليها والتي تصل الى  $200 \text{ mom}$ . ان تسخين الاجهزه جرى بمساعدة مصادر التيار المستقر دائما وحسب الصيغة التالية-  $\text{HY3010E0-30B/0-10A}$ .

للغرض الاشعاع استخدم المصباح ذات الاضاءة البنفسجية ARL 12-5213 UVC ذات الموجة الطويلة  $400 \text{ nm}$  وبمساعدة  $76 \text{ mbt}$  والذي يتمدد على مسافة  $2 \text{ mm}$  على الغشاء الاستشعاري الغازي . عند بحث تاثير فاعلية المصباح على مؤشر التركيب المختبرى للمقياس فان ذلك يقودنا الى القياس الدقيق للخلايا بحجم  $10 \mu\text{m}$  لانبوبة الاضاءة الصامته .

لقد تم البحث في تاثير المصباح ذات الاشعاع البنفسجي على مقاومة مواد اجهزة استشعار الغازات . وقد اعتمد على ان مدى مقاومة المواد التحسسية تقل بسرعة تحت تاثير الضوء ومن ثم تبدا تنخفض ببطء وبعد اطفاء الضوء تبدا الازدياد لكي تبلغ ما كانت عليه في السابق.

لاجل تبسيط البحث في مدى فاعلية الضوء على اجهزة استشعار الغاز يمكن النظر الى وقت الفعال للتجانس ،والذى يتصف بطول التغير السريع لالمقاومة عند تشغيل الضوء ، وطول فترة التجانس البطيء والتجانس بعد اغلاق الضوء. كل وقت فعال من تلك الازمنة يتوضّح ببعض الروابط الاسمية.

ان تاثير الضوء البنفسجي على مقاومة المادة التحسسية تؤدي الى تقليل المقاومة الكهربائية بنسبة  $28\%$  من حساب الحامل الغير متكافئ للأجهزة. ان طول الانجاز لمعنى لمقاييس المقاومة المنخفضة  $10 \Omega$  تشكل خلال  $5$  دقائق بشكل منتظم ،وبانسجام بطيء حيث يساوي  $10 \Omega = 20 \Omega$  دقائق او الانسجام بعد اغلاق الضوء والذي يساوي  $20 \Omega = 30 \Omega$  دقيقة. يجب الاشارة هنا الى انه عند اغلاق الضوء فان المقاومة لا تعود الى قيمها الاساسية كما كانت في السابق . المخطط رقم ١.



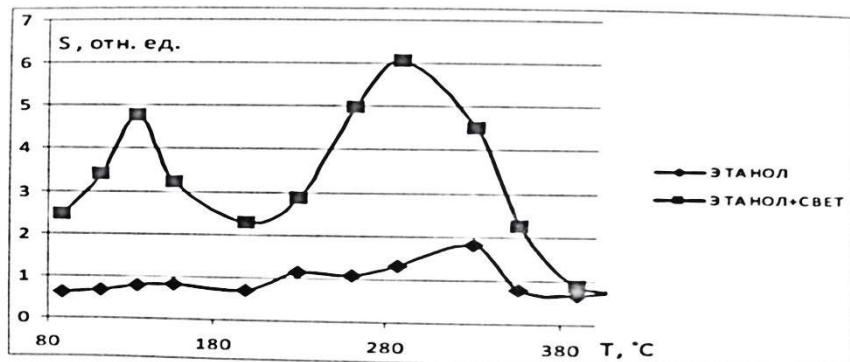
المخطط رقم ١ يوضح تغير مدى المقاومة للمادة التحسسية تحت تأثير نبضات الضوء البنفسجي المتدايق.

انثناء التأثير الغازي يمكن ان تحصل عملية اعادة تحميل لحالة السطح الواقع تحت تأثير الضور والذي يقود الى التغيير في ازدياد الاستشعار الغازي . ولذلك تم بحث تغير نسبة المقاومة للمواد الاستشعرية لاجهزه استشعار الغازات عندما تتأثر بابخرة مواد مختلفة في الهواء وواقعة تحت تأثير الاشعاع البنفسجي .

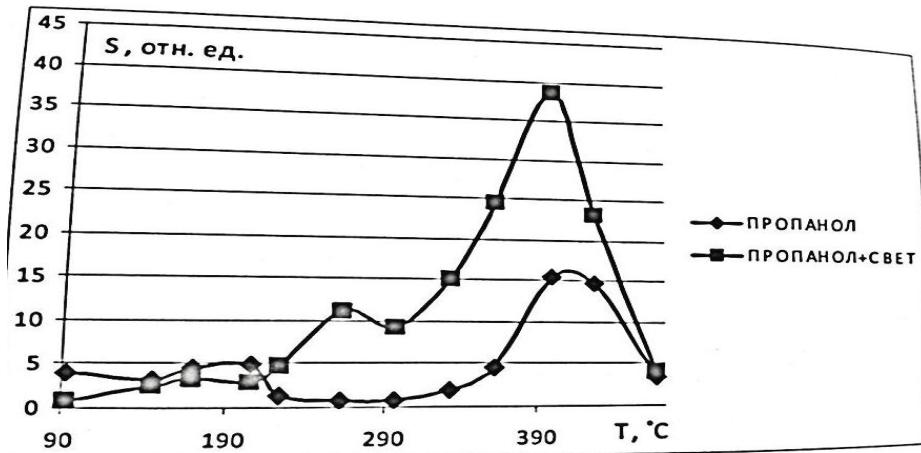
تم بحث التحسس الغازي للتركيب المختبرية لابخرة الايثيل و محلول الايزوبروبيل والاسيتون في الهواء . ان الترابط الحراري للتحسس الغازي لمحلول الايثيل في الهواء وكذلك التأثير البصري عند وجود محلول الايثيل كلها قد تم توضيحيها في المخطط رقم ٢ .

تم البناء على ان التحسس الغازي الاقصى لابخرة محلول الايثيل في الهواء ppm ١٧٠٠ بدون تأثير الضوء تظهر عند درجة حرارة ٣٣٠ درجة مئوية وتشكل ١.٨ وحدة نسبية . عند اضافة التركيب المختبرى بضوء الحرارة القصوى للتحسس الغازي ٢٩٠ درجة عند ذلك يتضاعف التحسس الغازي الى ٦ وحدات نسبية وكذلك يظهر التحسس الاضافى الاقصى بدرجة حرارة ١٣٠ بمضاعفة ٤.٨ وحدة نسبية . ان ارتباط الحرارة بالتحسس الغازي لابخرة الايزوبروبيل في الهواء وكذلك التأثير البصري عند وجود محلول الايزوبروبيل قد تم توضيحيه في المخطط رقم

.٣



المخطط رقم ٢ يوضح ارتباط الحرارة بالتحسس الغازي لابخرة محلول الايثيل ١٧٠٠ اثناء الاضاءة بالمصباح واثناء انعدامها. المخطط رقم ٣.

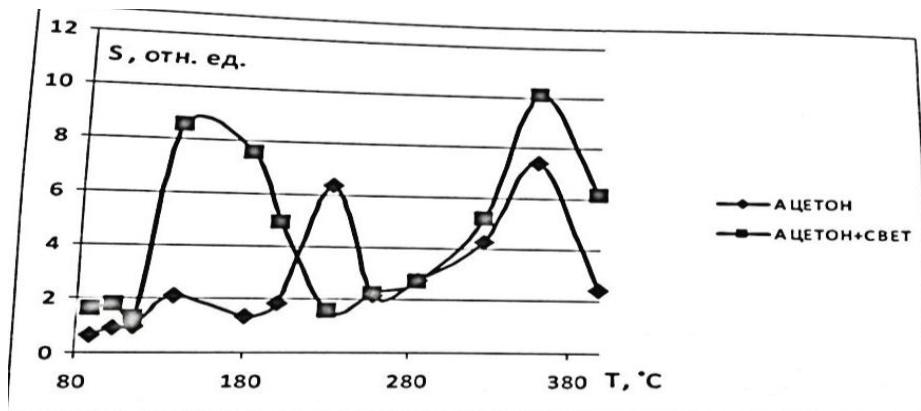


المخطط رقم ٣ يوضح ارتباط الحرارة بالتحسس الغازي لابخرة محلول الايزوبروبيل ١٣٠٠ اثناء الاضاءة بالمصباح واثناء انعدامها.

ان درجة التحسس الغازي القصوى لابخرة محلول الايزوبروبيل ١٣٠٠ في الهواء بدون تأثير الضوء تظهر عند درجة حرارة ٤٠٠ درجة مئوية وتشكل نسبة ١٥.٥ درجة نسبية. عند اضاءة التركيب المختبرى بالمصباح فان درجة الحرارة القصور للمتحسس الغازي عمليا لا تتغير وتتضاعف درجة التحسس الغازي الى ٣٨.٧ وحدة نسبية وتظهر كذلك التحسس الاضافى الاقصى عند درجة حرارة ٢٦٠ درجة بزيادة ١١.١ درجة نسبية .

ارتباط الحرارة بالتحسس الغازي لابخرة الاسيتون في الهواء وكذلك في التأثير البصري عند وجود الاسيتون قد تم توضيحه في المخطط رقم ٤.

ان درجة التحسس الغازي القصوى لابخرة محلول الاسيتون ١٧٠٠ في الهواء بدون تأثير الضوء تظهر عند درجة حرارة ٣٦٠ درجة مئوية وتشكل نسبة ٧.٤ درجة نسبية. عند اضاءة التركيب المختبرى بالمصباح فان درجة الحرارة القصور للمتحسس الغازي عمليا لا تتغير وتتضاعف درجة التحسس الغازي الى ١٠.١ وحدة نسبية وتظهر كذلك التحسس الاضافى الاقصى عند درجة حرارة ١٣٦ درجة بزيادة ٨.٦ درجة نسبية .المخطط رقم ٤.

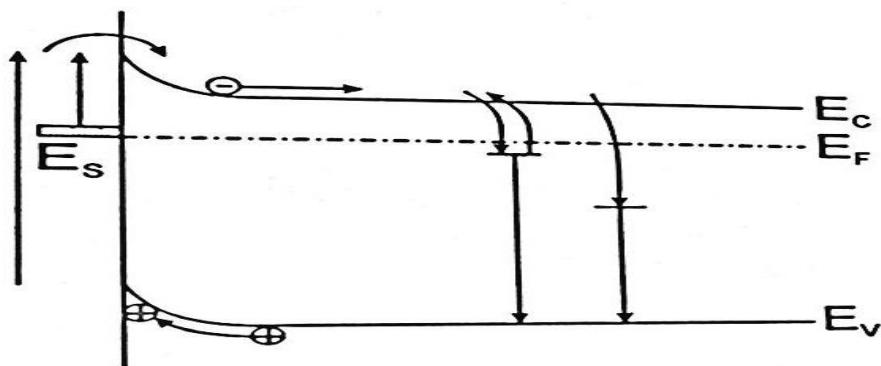


المخطط رقم ٤ يوضح ارتباط الحرارة بالتحسس الغازي لابخرة محلول الاسيتون ١٧٠٠ اثناء الاضاءة بالمصباح وانثناء انعدامها.

في كل التجارب المنفذة فان تاثير الضوء يزيد من التحسس الغازي لابخرة الالثيل ومحلول الايزوبروبيل والاسيتون بنسبة ١.٥ - ٣ مرات بدون تغير في درجة الحرارة للتحسس الاقصى عدا ذلك فان انخفاض درجات الحرارة الى ١٣٠ - ٢٦٠ يظهر التحسس الاضافي الاقصى للغاز بدرجة كفاءة عالية او مقاربة بمضاعفة اجهزة الاستشعار للغاز المناسب بدون اضاءة. يشير ظهور درجة حرارة واطئة للمتحسس الغازي الى ان فوتون الضوء ينشط الميكانيكة الحديثة لاستشعار الغاز الغير متواجد في الاشكال الغير مضاءة. تلك التقنية يمكن ان تؤدي الى تاثير الضوء الغير مباشر على وضع الاسطح الحاملة وفاعليتها وكذلك التاثير القليل للحرارة على جزيئات الغازات المسيطر عليها. عند ذلك فان درجة الحرارة القصوى لاجهزة الاستشعار الغازية للالثيل والايزوبروبيل والاسيتون تشير الى ٣-٢ مرة اقل من درجة الحرارة القصوى لنفس الغاز ولكن عند غياب التاثير الضوئي على السطح المتحسس.

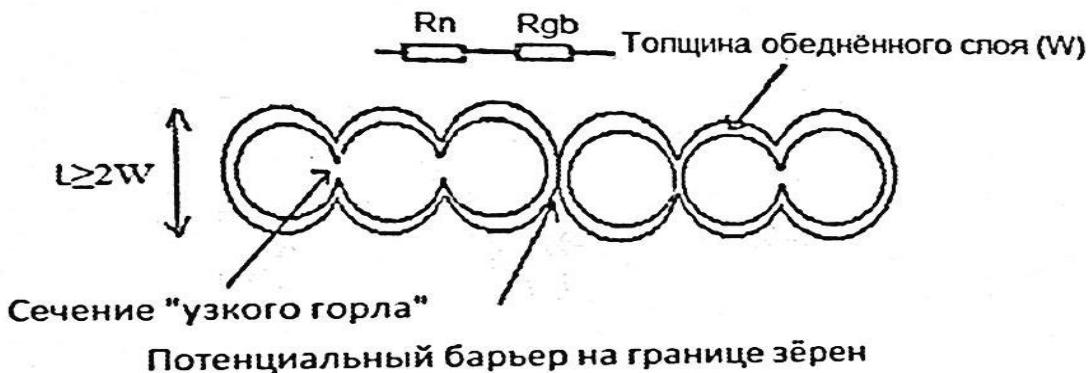
عند اضاءة اشباه الموصل ثانى اوكسيد القصدير بالضوء مع الطاقة سيسع نطاق المنطقة المحظورة بحجم اشباه الموصلات تتولد ابخرة من الحفر الالكترونية لاجل حني المنطقة عند السطح يجري تقسيم الشحنات في مجال التوحيد : الحفر تكون على السطح اما الالكترونيات فانها تنتقل الى عمق البثورات مضاعفا للتركيز العام لحامل الشحنات الحر ومحضها لحجم المقاومة . ان تاثير الحفر غير المتساوية على السطح يمكن ان تقود الى تخفيض درجة الزيادة في الحاجز الممكنة للبثورات . عند ذلك يمكن ان يتم الانتقال المباشر للشحنات باضاءة السطح الخارجي والذي يقود الى التغيير الكبير في الحاجز الممكنة والى تقليل مقاومة السطح . ان الفاعلية الاخيرة يجب ان تكون متحسبة بشكل قوي للتركيز وللشحنات الموجودة على السطح الخارجي ويجب الاخذ بنظر الاعتبار درجة امتلاء وكمية الشحنات على السطح الخارجي لمراكز الامتزاز . مخطط العمليات انفة الذكر تم توضيحها في المخطط رقم ٥ .

في المخطط رقم ٦ تم توضيح التركيب الحبيبي للمعدن الموكسد شبه البلوري . يمكن ملاحظة فاعلية اطراف الحبيبات وعنقها الضيق في الشكل المرسوم . المخطط رقم ٥ .



في المخطط رقم ٥ تظهر عملية الانتقالات الظاهرة عند اضاءة شبه الموصل  $\text{SnO}_2$  ثانى اوكسيد القصدير بالضوء مع الطاقة سيسع نطاق المنطقة المحظورة .

عند انحدار الاشعاع البنفسجي بموجة عالية تصل الى ٤٠٠ على الغطاء شبه البلوري للمعدن المؤكسد تتشكل ازواجا من الحفر الالكترونية في مجال اضعاف الحبيبات .الاثارة الصورية تقلل من ارتفاع الحاجز الحبيبي العام، وبنفس الوقت تضاعف من كثافة الناقل الحر في كل المادة وتنتسبع خاصية المخطط رقم ٦.



#### المخطط رقم ٦ . التركيب الحبيبي للمعدن المؤكسد شبه البلوري.

ان بحث تأثير الاشعة فوق البنفسجية على ميكانيكية الاستشعار لاجهزة قياس الغازات المعدنية المؤكسدة قد تم بحثه استنادا للاقتراءات النظرية . وقد تم التأسيس من قبل الباحثين على ان الاشعاع البنفسجي يمكن ان يقوي عملية التوصيل بشكل كبير وكذلك خاصية الاستشعار لاجهزة القياس الاستشعار المعدنية المؤكسدة حتى في درجة حرارة الغرفة . ان التحسس يزداد بمضاعفة كثافة التيار للأشعة فوق البنفسجية ويقل بمضاعفة حجم الحبيبة . عدا ذلك فان مقاومة المعدن المؤكسد للاشعاعية الواقعية تقل بحساب الاشعة فوق البنفسجية بالمقارنة مع عدم وجود تلك الاشعة . بهذا الشكل فان اضاءة اجهزة القياس الاستشعارية المعدنية المؤكسدة بالأشعة بالمقارنة مع المنطقة الممنوعة الواسعة للمعدن المؤكسد يمكن ان يقل درجة الحرارة العالية في العمل . ان ذلك يسمح باستخدامه تلك المجالات التي لا يمكن العمل فيها اثناء ارتفاع درجات الحرارة حيث ترتفع امكانية تطبيقه بشكل كبير .

## الخاتمة

في التراكيب المختبرية لاجهزة قياس الغازات المعدة بتقنية الالكترونيات الدقيقة للطبقات المتحسسة للتركيب  $\text{SnO}_2$  قد بحثت سمات التغير لصورة التيار نتيجة الاضاءة بالمصابح ذات الضوء البنفسجي ( $\lambda = 400$  nm). تم تحديد خصائص تغيير وتاثير الوقت على انسجام مقاومة المادة المتحسسة عند تشغيل واطفاء الضوء. وقد تم بحث ارتباط درجات الحرارية للتراكيب المختبرية لاجهزة التحسس الغازية لابخرة الايثيل و محلول الايزوبروبيل والاسيتون في حالة انعدام الاضاءة و عند اضاءة المصابح ذات الضوء البنفسجي . في تلك الالثناء فقد تم الاعتماد على الفاعلية البصرية لسطح  $\text{SnO}_2$  والتي تزيد من نسبة الاستشعار الغازي في اجهزة القياس . عند تاثير الضوء تظهر الزيادة القصوى للتحسس الغازي في درجة حرارة ما بين ٢٦٠ - ١٠٠ °C اكثراً بمرتين عن درجة الحرارة القصوى لاجهزة قياس الغازات بدون اضاءة . لقد اخذنا بنظر الاعتبار التقنيات الممكنة لتاثير الضوء على التحولات البصرية للمساحات العامة وبشكل مباشر على الاسطح الخارجية لاغشية  $\text{SnO}_2$  .

نُفذ العمل البحثي بدعم مالي من الجهة الساندة .

## المصادر

- ١ - مياسنيكوف ي.ا. اجهزة الاستشعار شبه الموصلات في الابحاث الفيزيائية الكيميائية . موسكو دار نشر العلوم، ١٩٩١. ص ٣٢٧.
- ٢ - Vaccaro P.O. photoconductivity in stannioxide film ,prerared by spray pyrolysis. Sci.lett.1990.-vol.9.-389-390.
- ٣ - Camagni. P. photoconductivity activation of SnO<sub>2</sub> thin film gas sensors at room temperature.sensors and actuators B chemical.,1996.-vol. 31-p. 99-103.
- ٤ - Comini E. UV light activations of tin oxide thin films for NO<sub>2</sub> SENSING FT LOW TEMPERATURE .sensore and actusator,2001.vol,78.- p.73-77.
- ٥ - Mishra S. Detection mechanism of metal oxide gas sensor under uv radiation.sensor of actuaion./,2004.b 91-p.387-390.
- ٦ - ريمبيزا س.ي. خصائص التركيب والتقنية لاعداد اجهزة قياس الغازات التكاملية للمعادن المؤكسدة ذات الااغشية الرقيقة .اجهزه الاستشعار ،٤، №.٢٠٠٤ – ص ٢٠-٢٦.
- ٧ - روسيخ ا.ي. قياس الخصائص الفولتية الامبيرية للتراكيب المختبرية ذات الااغشية الرقيقة لثاني اوكسيد القصدير si %١+ . جامعة فارونيش التقنية الحكومية . ٢٠١٢ . الجزء ٨ . ٦٢-٥٩ ، ص ١-١٠.
- ٨ - روسيخ د.ف. الانسجام البصري للااغشية المقاومة الكهربائية المدعمة لثاني اوكسيد القصدير . FTP. ٢٠٠٩، b6.٤٣ ، الجزء ٤١١-٨١٥ ، ص ٦٦-٤٣.